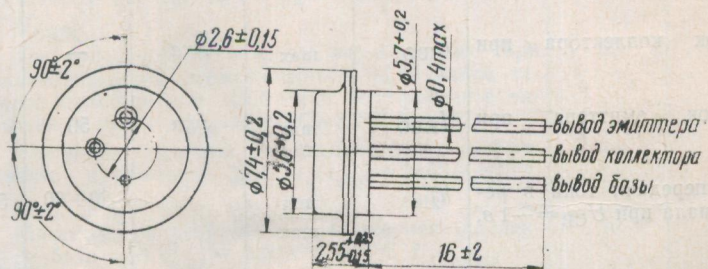




ПАСПОРТ

Транзисторы германиевые р-п-р типов:
1Т115А, 1Т115Б, 1Т115В, 1Т115Г

Соответствует частным техническим условиям
0.336.003 ТУ, ред. 1—68.



Вес не более 0,6 г.

1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п. п.	Наименование параметров и режимы измерения	Усл. обозначения	Норма	Един. измер.	Типы транзисторов			
					1Т115А	1Т115Б	1Т115В	1Т115Г
1	Обратный ток коллектора при $U_{CB} = -50$ в	I_{CBO}	max	мкА	50	50	—	—
	Обратный ток коллектора при $U_{CB} = -70$ в	I_{CBO}	max	мкА	—	—	50	50
2	Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = -50$ в	I_{EBO}	max	мкА	50	50	50	50
3	Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{CB} = -1$ в, $I_E = 25$ ма	h_{21e}	min max		20÷60	50÷150	20÷60	50÷150
4	Предельная частота передачи тока при $U_{CB} = -5$ в, $I_E = 5$ ма	f_{h21b}	min	МГц	1	1	1	1
5	Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_C = 100$ ма, $I_B = 20$ ма	$U_{CE sat}$	max	мВ	200	150	200	150

2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№ п. п.	Наименование режимов	Един. измер.	Типы транзисторов			
			1Т115А	1Т115Б	1Т115В	1Т115Г
1	Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при подаче запирающего напряжения между эмиттером и базой при $t_{амв} = -60^{\circ}\text{C} \div +73^{\circ}\text{C}$ $U_{сэм}$	<i>в</i>	—50	—50	—70	—70
2	Ток коллектора в режиме переключения при скважности ≥ 2 , времени фронта ≤ 10 мксек, частоте переключения ≤ 50 гц и коэффициенте насыщения ≥ 3 и $t_{амв} = -60^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$ $I_{C\text{ sat}}^*$	<i>ма</i>	100	100	100	100
3	Ток базы в режиме насыщения при коэффициенте насыщения ≥ 3 и $t_{амв} = -60 \div +73^{\circ}\text{C}$ $I_{B\text{ sat max}}$	<i>ма</i>	20	20	20	20
4	Максимально допустимые напряжения коллектор—база при $t_{амв} = -60^{\circ}\text{C} \div +73^{\circ}\text{C}$ $U_{св\text{ max}}$	<i>в</i>	—50	—50	—70	—70
5	Максимально допустимое напряжение эмиттер—база при $t_{амв} = -60^{\circ}\text{C} \div +73^{\circ}\text{C}$ $U_{ев\text{ max}}$	<i>в</i>	—50	—50	—50	—50
6	Мощность, рассеиваемая на транзисторе P_{max}^{**}	<i>мвт</i>	50	50	50	50
7	Температура окружающей среды $t_{амв}$	$^{\circ}\text{C}$	от -60°C до $+73^{\circ}\text{C}$			

* При $t_{амв}$ свыше $+55^{\circ}\text{C}$ величина $I_{C\text{ sat}}$ снижается линейно до 40 ма.

** При температуре окружающей среды свыше $+55^{\circ}\text{C}$ предельная величина мощности определяется по формуле:

$$P_{\text{max}} = \frac{85^{\circ}\text{C} - t_{амв}^{\circ}\text{C}}{0,6^{\circ}\text{C}/\text{мвт}} (\text{мвт}).$$

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРИБОРОВ

1. Складские условия:

- температура окружающего воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность до 85 %;
- отсутствие в воздухе кислотных и других агрессивных примесей.

2. Полевые условия:

- температура окружающего воздуха может изменяться в пределах от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность до 98 % при температуре $+30^{\circ}\text{C}$.

4. ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует наработку транзисторов в составе модуля не менее 10000 час.

Срок хранения — 12 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки приборов.

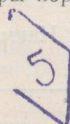
5. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе работы не разрешается превосходить предельно допустимые значения токов, напряжений, мощности и температуры транзистора.

Не допускается использование транзисторов в предельных режимах одновременно по двум или более параметрам.

Рекомендуется принимать меры по обеспечению минимальной температуры корпуса транзистора.

Штамп
представительства
заказчика



Штамп
ОТК



6. РЕКЛАМАЦИИ

В случае преждевременного выхода прибора из строя данный прибор возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих данных:

Время хранения _____
(заполняется, если прибор не был в эксплуатации)

Общее число часов работы прибора _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причина снятия прибора с эксплуатации или хранения _____

Сведения заполнил _____

ВНИМАНИЕ!

По окончании эксплуатации прибора (если прибор снят с эксплуатации после истечения срока гарантированной наработки) просим сообщить предприятию-изготовителю сведения, указанные в разделе 6 паспорта

Зак. 7401